

Single

Fast Recovery Diode

DE3L20UA

200V 3A

特長

- SMD
- 低ノイズ
- trr = 35ns

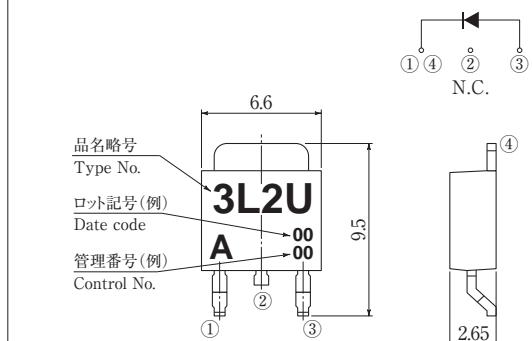
Feature

- SMD
- Low Noise
- trr=35ns

■外観図 OUTLINE

Package : Epack

Unit:mm



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25°C)

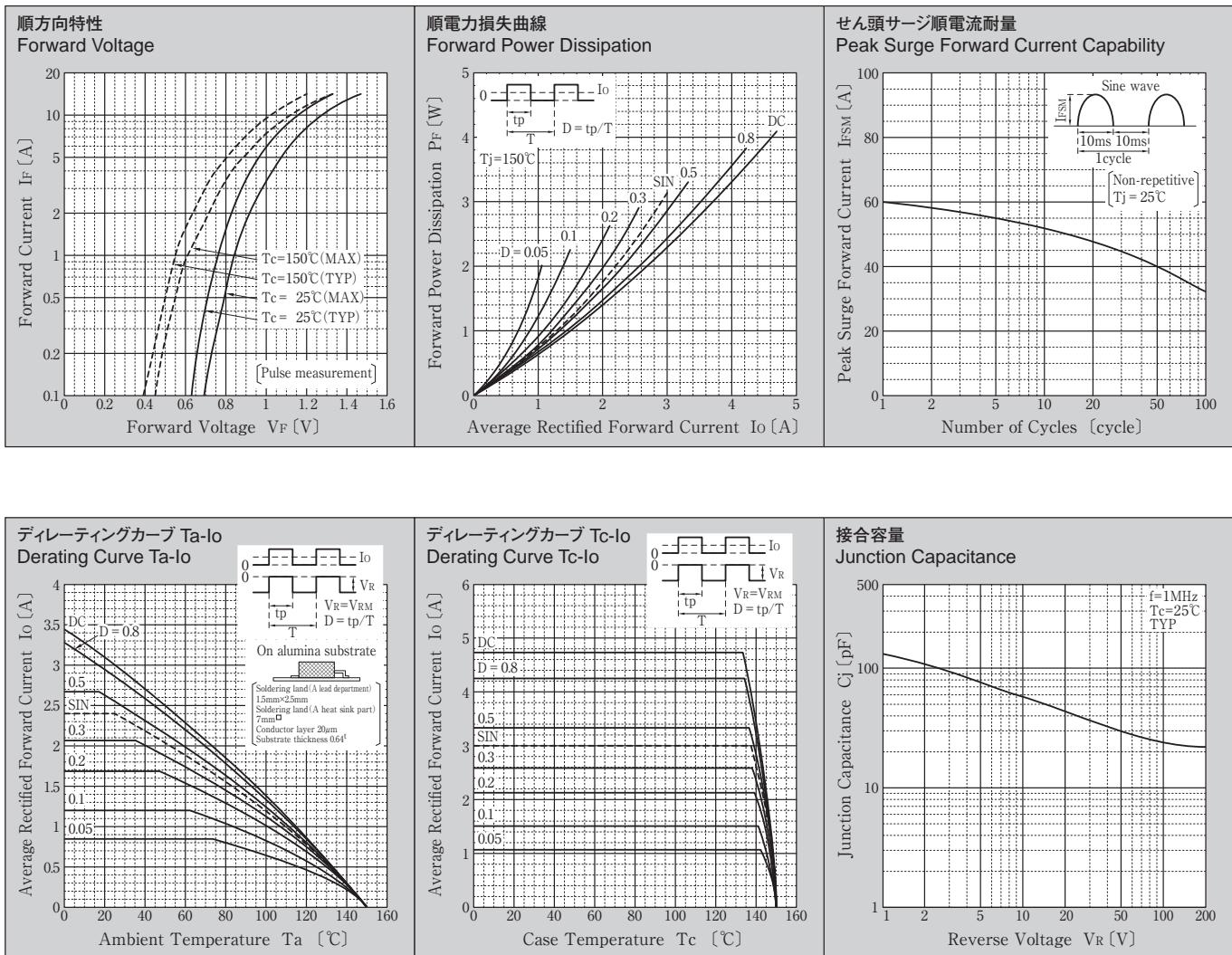
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}		200	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, T _c = 137°C 50Hz sine wave, Resistance load, T _c = 137°C	3	A
		50Hz 正弦波, 抵抗負荷, T _a = 25°C アルミナ基板実装*1 50Hz sine wave, Resistance load, T _a = 25°C on alumina substrate*1	2.4	
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C	60	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 3A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.98	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = 200V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F = 0.5A, I _R = 1A	MAX 35	ns
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V	TYP 56	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 4	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	MAX 55	

*1 アルミナ基板実装 (1インチ基板)
Measured on the 1×1 inch alumina substrate

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.